

제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

E. Compound Semiconductors 분과

Room F

죽실 (본관, 5층)

2013년 2월 5일(화) 10:55-12:10

[TF2-E] Compound Semiconductor II

좌장: 임종원(한국전자통신연구원), 차호영(홍익대학교)

[초청]

- | | | |
|---------|-------------|--|
| TF2-E-1 | 10:55-11:25 | GaN 전력반도체 상용화를 위한 기술 이슈
장태훈
LG전자 System IC 연구소, IGBT Part |
| TF2-E-2 | 11:25-11:40 | Ti/Ni 이중막을 이용한 p형 및 n형 SiC Ohmic Contact의 동시 형성
주성재 ¹ , 백상원 ² , 김상철 ¹ , 이정수 ²
¹ 한국전기연구원 전력반도체 연구센터, ² 포항공과대학교 전기전자공학과 |
| TF2-E-3 | 11:40-11:55 | Analysis of Series Resistance and Interface State Density of Pd/Ni/n-GaN Schottky Diode in Wide Temperature Range
M. Siva Pratap Reddy ¹ , V. Sindhuri ¹ , Dong-Hyeok Son ¹ , Dong-Seok Kim ¹ ,
Hee-Sung Kang ¹ , Young-Woo Jo ¹ , Chul-Ho Won ¹ , Mi-Kyung Kwon ¹ , Kyu-il
Jang ¹ , Jung-Hee Lee ¹ , and V. Rajagopal Reddy ²
¹ School of Electrical Engineering & Computer Science, Kyungpook
National University, ² Department of Physics, Sri Venkateswara University |
| TF2-E-4 | 11:55-12:10 | Field Plate를 구비한 Normally-Off GaN MISFET 소자의 특성
안호균 ^{1,2} , 김정진 ^{1,3} , 임종원 ¹ , 배성범 ¹ , 고상춘 ¹ , 장우진 ¹ , 문재경 ¹ , 남은수 ¹ ,
이정희 ²
¹ 한국전자통신연구원 융합부품소재연구부문 광무선융합부품연구팀
RF융합부품연구팀, ² 경북대학교 전자전기컴퓨터공학부, ³ 전북대학교
반도체화학공학부 |